ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ДИХАЛЬКОГЕНИДОВ ТИТАНА ${ m TiX_2}~({ m X}={ m S},\,{ m Se},\,{ m Te})$

А. С. Шкварин^a^{*}, Ю. М. Ярмошенко^a, Н. А. Скориков^a, М. В. Яблонских^b, А. И. Меренцов^{a,c}, Е. Г. Шкварина^a, А. Н. Титов^{a,c}

^а Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук 620990, Екатеринбург, Россия

^bSincrotrone Trieste SCpA, Basovizza I-34012, Italy

^с Уральский федеральный университет 620089, Екатеринбург, Россия

Поступила в редакцию 25 марта 2011 г. после переработки 9 июня 2011 г.

Проведено систематическое экспериментальное и теоретическое исследование электронной структуры и химической связи в дихалькогенидах титана ${\rm TiX}_2$ (X = S, Se, Te), перспективных электродных материалах литиевых батарей. Установлено, что рентгеновские фотоэлектронные спектры валентных полос и внутренних уровней, а также рентгеновские $L_{2,3}$ -спектры поглощения титана наглядно демонстрируют изменение ионной и ковалентной составляющих химической связи в этих соединениях. Выполнены теоретические расчеты плотности электронных состояний полнопотенциальным методом присоединенных плоских волн и атомные мультиплетные расчеты рентгеновских $L_{2,3}$ -спектров поглощения титана. Показано, что в ряду ${\rm TiS}_2-{\rm TiSe}_2-{\rm TiTe}_2$ происходят увеличение ковалентности, понижение ионности химической связи и ослабление влияния кристаллического поля лиганда.

1. ВВЕДЕНИЕ

Дихалькогениды переходных металлов (TMDC) и соответствующие интеркалаты более тридцати лет привлекают внимание своими уникальными свойствами [1-3]. Однако электронные характеристики ТМDС изучены до сих пор далеко не полно, а результаты проведенных исследований в итоге часто дают противоречивую картину. Например, TiTe₂ обнаруживает полуметаллические свойства [4], а 1T-TiSe₂ по экспериментальным и теоретическим данным проявляет как полуметаллические [5, 6], так и полупроводниковые свойства [7]. ТМDС подобно графиту состоят из композитных слоев Х-Ті-Х, так называемых сэндвичей (рис. 1, вверху), связанных слабым ван-дер-ваальсовым взаимодействием по кристаллографическим плоскостям (0001). Такие слоистые структуры проявляют квазидвумерное поведение, поэтому подобные соединения можно рассматривать в качестве модели при переходе

от трехмерных к двумерным материалам. TMDC очень хорошо поддаются внедрению других атомов, причем физические свойства интеркалированных соединений радикально отличаются от свойств материнского соединения. В электрохимических батареях применяется обратимая интеркаляция с использованием окислительно-восстановительной реакции с переносом заряда от интеркалата в слой матрицы. Такая батарея с TiS₂-катодом и Li-анодом была впервые запатентована еще в 1973 г. [8]. В качестве возможных приложений рассматриваются проводники с сильной анизотропией и упорядоченные магнитные системы. В рассматриваемых соединениях атомы титана и халькогена проявляют формальную валентность соответственно 4+ и 2-. Несмотря на это, соединения, полученные с помощью интеркаляции и замещения атомов титана атомами переходных металлов, проявляют различные физические свойства, напрямую зависящие от исходной матрицы TiX₂ [3,8]. Хотя исследования дихалькогенидов титана имеют многолетнюю историю, класси-

^{*}E-mail: shkvarin@ifmlrs.uran.ru



Рис.1. Вверху приведен фрагмент кристаллической структуры дихалькогенида титана. Показан один «сэндвич», ван-дер-ваальсова щель и часть следующего «сэндвича». Внизу приведены проекции электронной плотности на плоскость, содержащую ось кристалла с. Проекции даны в одинаковом масштабе, однако реально расстояние между атомом титана и халькогена увеличивается из-за роста параметров ячейки (табл. 1)

ческие спектральные методы (рентгеновская фотоэмиссионная спектроскопия — XPS, рентгеновская абсорбционная спектроскопия — XAS) применялись эпизодически в совершенно разных условиях синтеза и спектрального эксперимента. Вызванные этим неполнота и большой разброс экспериментальных данных не позволяют подходить к анализу формирования электронной структуры и физических свойств в конкретных соединениях с общих позиций.

В этой работе изучены рентгеновские фотоэлектронные спектры валентных полос и внутренних уровней, а также рентгеновские L_{2,3}-спектры поглощения титана в трех дихалькогенидах титана — ${\rm TiS}_2$, ${\rm TiSe}_2$ и ${\rm TiTe}_2$ — в одинаковых экспериментальных условиях. Выполнены теоретические расчеты плотности электронных состояний (DOS) полнопотенциальным методом присоединенных плоских волн и атомные мультиплетные расчеты рентгеновских *L*-спектров поглощения титана.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ И РАСЧЕТ

Поликристаллические образцы TiS_2 , $TiSe_2$ и $TiTe_2$ были синтезированы ампульным методом. Порошковая дифрактометрия показала хорошее качество образцов. Монокристаллы выращены методом газотранспортных реакций с использованием I_2

	$a, \mathrm{\AA}$	$c, \mathrm{\AA}$	$z, \mathrm{\AA}$	4zc/a
${ m TiS}_2$	3.408	5.699	0.25	1.726
${ m TiSe}_2$	3.540	6.008	0.255	1.732
TiTe ₂	3.777	6.498	0.2628	1.808

Таблица 1. Структурные параметры для системы TiX_2 (X=S, Se, Te)

Примечание. z — координата селена по оси c, 4zc/a — параметр, характеризующий отклонение халькогенного октаэдра от идеального, для которого 4zc/a = 1.633.

в качестве носителя из поликристаллической фазы. Монокристаллы имеют форму тонких пластинок размерами около 2 × 2 × 0.05 см³. Химический состав был определен на спектрометре JEOL-733 и показал неизменность состава монокристалла в процессе роста.

Все измерения проведены на линии ВАСН синхротрона ЭЛЕТТРА [9]. Фотоэлектронные спектры получены с помощью фотоэлектронного анализатора VSW150 с углом анализируемого излучения 8°. Спектры поглощения получены в режиме полного тока (ТЕҮ). Образцы были сколоты в вакуумной камере при давлении меньше чем 1 · 10⁻⁹ Торр (3-5 · 10⁻¹⁰). Для контроля за чистотой поверхности время от времени снимались фотоэлектронные спектры остовных 1s-уровней углерода, 1s-уровней кислорода и 2*p*-уровней титана. Чистота поверхности подтверждается отсутствием пиков кислорода и углерода. Неизменность формы 2*р*-пика титана в течение времени проведения эксперимента, а также отсутствие оксидного пика также подтверждают чистоту поверхности.

Угол между падающим излучением и нормалью к базисной плоскости составлял 60°. Направление оси анализатора совпадало с направлением оси *с* образца. Плоскость оси *с* [001] образца и плоскость поляризации исходящего излучения были горизонтальными.

Разрешение монохроматора (т. е. разрешение спектров поглощения) на 2p-крае титана составляло $E_{mono} = 0.12$ эВ. Разрешение фотоэлектронного анализатора было $E_{pa} = 0.147$ эВ, что дает общее разрешение $E_{tot} = 0.19$ эВ. Калибровка энергии связи выполнена по спектрам $4f_{7/2}$ -линии Аu и измерению спектра золота в окрестности энергии Ферми. Спектры поглощения титана в матрицах калибровались по спектру поглощения чистого титана.

Расчеты зонной структуры были выполнены в рамках полнопотенциального метода линеаризованных присоединенных плоских волн (FP-LAPW), реализованного в программном пакете Wien2k [10]. Интегрирование в зоне Бриллюэна проводилось по сетке 14 × 14 × 7 специальных **k** точек. В расчетах использовались экспериментально определенные параметры кристаллической структуры, приведенные в табл. 1 [11], пространственная группа для всех дихалькогенидов взята *P*-3*m*1 (164). Для расчета были выбраны радиусы атомных сфер $R_{\rm Ti} = 2.5$ ат. ед., $R_{\rm Se} = 2.17$ ат. ед., $R_{\rm Te} = 2.26$ ат. ед. и $R_{\rm Se} = 2.44$ ат. ед.

3. СПЕКТРЫ ВАЛЕНТНЫХ ПОЛОС

Спектры валентных полос рассматриваемых соединений очень похожи по своей форме (рис. 2). Основной спектр в энергетическом диапазоне 0–6 эВ состоит из трех подполос. Их положение в шкале энергии связи дано в табл. 2.

В этом энергетическом диапазоне расположены *пр*-состояния халькогена, 3*d*- и 4*s*-состояния валент-



Рис. 2. Спектры валентной полосы для TiS_2 , TiS_2 , TiS_2 , TiS_2 , TiS_2 , TiS_2 , TiTe_2 . Буквами A, B, C и D обозначены основные полосы спектра. Полоса D содержит только s-состояния халькогена; δ — ширина спектра на его полувысоте. Штрихпунктирными линиями показаны рассчитанные спектры валентных полос. Эти спектры являются результатом суммирования плотности состояний электронов различной орбитальной симметрии с учетом их сечения фотоионизации, взятых из работы [12], и концентрации атомов. Спектры размыты на функцию аппаратурного уширения величиной $\Delta E = 0.4$ эВ

	A, эВ	B, эВ	C, эВ	D, sB	δ, эB
TiS_2	2.425	3.647	5.12	12.99	4.23
TiSe_2	2.207	3.144	4.87	13.6	3.83
TiTe_2	_	2.604	4.72	11.8	3.77

Таблица 2. Положения максимумов, соответствующих рис. 2; δ — ширина на полувысоте для соответствующих спектров

ных электронов титана. В диапазоне 10-15 эВ расположены ns-состояния халькогена. Форма спектра всей валентной полосы зависит от величины вкладов электронных состояний различной орбитальной симметрии и их сечения фотоионизации (при данной энергии возбуждения) для атомов химических элементов, входящих в состав соединения. Сечение фотоионизации пр-электронов халькогена превышает сечение фотоионизации 3d-электронов Тi на порядок величины [12]. Поэтому основную часть спектра (0-5 эВ) формируют *пр*-состояния халькогена. Для атомов серы, кроме того, характерно аномально большое сечение фотоионизации 3s-электронов по сравнению с 3*p*-электронами, в отличие от сечений ns и np (n = 4, 5) других, рассматриваемых здесь соединений халькогена. Этим объясняется увеличение спектральной интенсивности 3s-полосы S в спектре TiS₂ по сравнению с другими соединениями.

Приведенная на рис. 3 (внизу) рассчитанная полная плотность состояний хорошо описывает основные полосы в экспериментальных спектрах валентных полос трех соединений (штрихпунктирные линии на рис. 2). В диапазоне энергии связи 0-5 эВ условно можно выделить три полосы, имеющие р-орбитальную симметрию халькогена А, В и С (рис. 2, табл. 2). С увеличением атомного номера наблюдается сдвиг полос В и С в направлении энергии Ферми, положение полосы А остается неизменным, как и ширины валентных полос. Согласно теоретическим расчетам пр-состояния халькогена (средняя часть рис. 3) занимают энергетический интервал шириной 5 эВ ниже энергии Ферми во всех трех соединениях. Однако в экспериментальных спектрах ширина основной полосы при переходе от TiS₂ к TiSe₂ и TiTe₂ уменьшается на 0.5 эВ. Происхождение этого хорошо известного спектрального эффекта объясняется действием аппаратурного уширения, поскольку происходит сдвиг подполос В и С в направлении энергии Ферми, соответствующий сдвиг испытывают и инструментальные «хвосты» от указанных по-

лос. Энергетическое распределение $p_{x,y,z}$ -состояний халькогена в занятой части валентной полосы (средняя часть рис. 3) почти одинаково, несмотря на квазидвумерность кристаллической структуры, в отличие от 3*d*-состояний Ті (верхняя часть рис. 3), для которых характерна энергетическая локализация. Плотность состояний $3d_{xy}$ и $3d_{x^2-y^2}$ титана значительно превышает плотность состояний $3d_{z^2}$ титана для всех рассматриваемых здесь соединений. Двумерность кристаллической структуры отчетливо наблюдается в проекции электронной плотности на плоскость, содержащую ось кристалла с (нижняя часть рис. 1). Более темные области рисунка соответствуют большим значениям электронной плотности, линии описывают поверхности с постоянной электронной плотностью, плотность линий на рисунке характеризует градиент электронной плотности. Электронная плотность внутри сэндвича TiX₆, отражающая химическую связь атомов титана с ближайшими соседями, значительно выше, чем на его границе. Такая пространственная анизотропия электронной плотности и энергетического распределения электронных 3d-состояний титана является причиной двумерности дихалькогенидов титана. Эти соображения были предсказаны еще в модели электронной структуры дихалькогенидов переходных металлов Вильсона и Иоффе [1]. Отметим здесь, что экспериментальные рентгеновские фотоэлектронные спектры валентных полос дихалькогенидов дают очень ограниченную информацию о формировании их электронной структуры. Причина этого заключается, в основном, в численном преобладании вклада *пр*-состояний валентных электронов атомов халькогена в спектре над всеми остальными.

4. ВНУТРЕННИЕ УРОВНИ И L_{2,3} XAS ТИТАНА

В отличие от рентгеновских фотоэлектронных спектров валентных полос TiX₂, спектры поглоще-

Таблица 3. Энергетические характеристики спектров XAS и XPS

	Полоса а, эВ	$\Delta E_{ab},$ эВ	ΔE_b , эВ	$E_{bind}^{\mathrm{Ti}\ 2p_{3/2}},\ \mathrm{sB}$
TiS_2	455.9	2.1	0.85	456.4
TiSe_2	455.7	1.8	1.0	455.5
TiTe ₂	455.2	1.5	1.35	455



Рис. 3. Рассчитанные полные плотности состояний для TiX₂ и парциальные плотности для 3*d*-состояния Ti и *s*- и *p*-состояний халькогена (внизу). Парциальные плотности состояний для $p_{x,y,z}$ -состояний халькогена (средняя часть). Парциальные плотности d_{xy} -, $d_{x^2-y^2}$ и d_{z^2} -состояний титана (вверху)

ния (правая часть рис. 4) и внутренних уровней (левая часть рис. 4) представляют значительный интерес для анализа формирования химической связи в этих соединениях. Из табл. 3 и рис. 4 следует, что происходит уменьшение энергии связи внутренней 2*р*-линии титана при переходе от X=S к X=Te. Наблюдаемый сдвиг свидетельствует, отчасти, в пользу уменьшения ионного вклада в химическую связь титана с его окружением. Это замечание важно, поскольку сами по себе энергетические сдвиги имеют сложную природу, и именно по этой причине мы рассматриваем цельную картину поведения внутренних уровней и спектров поглощения. Как оказалось, обе серии экспериментальных результатов дают согласованную картину. Спектры поглощения L_{2.3} исследованных образцов имеют довольно простую форму. Каждая мультиплетная компонента L₂ и L₃ расщеплена на две подполосы соответственно a, b и c, d

формирования электронной структуры, позволяют понять результаты расчета атомной мультиплетной структуры. Такая методика расчета, позволяющая

Обнаруженное

(рис. 4). В табл. 3 приведены энергия фотонов для

пика a, энергетическое расщепление подполос ΔE_{ab}

и полуширина пика b. Как следует из табл. 3 и рис. 4,

в ряду TiS₂-TiSe₂-TiTe₂ наблюдаются уменьшение

энергетического расщепления с одновременным уве-

личением ширины пика b, а также энергетический

сдвиг спектров в абсолютной шкале энергии фото-

энергетических характеристик спектров погло-

щения и остовных уровней свидетельствует об

увеличении ковалентного вклада в химическую

связь с увеличением атомного номера халькоге-

на. Какие физические причины лежат в основе

такого поведения спектров и, в конечном итоге,

экспериментально

изменение

HOB





Рис. 4. Слева приведены фотоэлектронные спектры 2p-уровня титана для TiX_2 (X = S, Se, Te). Справа приведены $L_{2,3}$ -спектры поглощения титана для TiX_2 (X = S, Se, Te)

	F_2, G_1, G_3	10Dq	Δ	U_{pd}	E_g	T_{2g}
${ m TiS}_2$	0.6	1.9	3	2.1	1.8	1.3
${ m TiSe}_2$	0.7	1.3	3	3.5	2	0.2
${\rm TiTe}_2$	0.9	0.8	3	4.5	2	0

Таблица 4. Параметры мультиплетного расчета для системы ${\rm TiX}_2$ (X = S, Se, Te)

описать взаимодействие 3*d*-электронов с вакансией на 2*p*-уровне, достаточно полно передает влияние симметрии ближайшего окружения и перенос заряда от 3*d*-металла к лиганду на форму спектра.

Атомные мультиплетные расчеты $L_{2,3}$ -спектров поглощения Ti^{4+} в октаэдрическом окружении (точечная группа O_h) выполнены с использованием программы [13]. Наилучшее согласие с экспериментом наблюдается при выборе параметров расчета L-спектра поглощения титана, приведенных в табл. 4.

Рассчитанные L_3 - и L_2 -компоненты мультиплета расщепляются в кристаллическом поле на (антисвязующие) орбитали $e_g(a, c)$ и $t_{2g}(b, d)$ (табл. 3, рис. 5). Из расчета следует, что основное влияние на расщепление спектра ΔE_{ab} оказывает кристаллическое поле, величина которого определяется параметром 10Dq. Полученное в расчете расщепле-

ние 10Dq меньше обнаруженного экспериментально ΔE_{ab} . Это различие объясняется не только размытием экспериментальных спектров на ширину внутреннего 2*p*-уровня титана и аппаратурным искажением. В простой картине для переходных металлов в октаэдрическом окружении два пика в L_3 - и L_2 -спектрах (соответственно по два в каждом) относятся к орбиталям с симметрией t_{2q} и е_д [14]. Ранее в работе [15] подробно изучено формирование XAS Ti⁴⁺ в октаэдрическом окружении для некоторых соединений. Поскольку в октаэдрическом окружении е_q-орбитали, направленные на лиганды, сильно связаны с ними, эти (антисвязующие) состояния имеют более высокую энергию по сравнению с t_{2g} -состояниями. Второй пик всегда имеет отношение к состояниям, сильно гибридизованным с лигандами. Вследствие принципа Фрэнка-Кондо [16] в конечном состоянии имеет место уширение, вызванное колебаниями решетки. В случае слабой гибридизации (t_{2g}) это уширение мало. Поэтому гибридизация сильно увеличивает ширину b- и d-пиков. Важной причиной уширения пиков на L₂-крае поглощения является сокращение времени жизни $2p_{1/2}$ -состояний, вследствие оже-распада Костера-Кронига [17, 18]. Кроме того, на ширину оказывает влияние энергетическая дисперсия полос. Суммарное действие этих эффектов называют уширением в твердом теле [15]. По этим причинам для оптимального описания расчетов мы использовали



Рис.5. Мультиплетный расчет для TiX2 (X = S, Se, Te). Штриховой линией приведен экспериментальный спектр

лоренцианы разной ширины для участков расчетного спектра, в которых преобладают орбитали соответственно типа t_{2g} и e_g . Результаты расчета с учетом различной ширины размытия для различных участков спектра хорошо согласуются с экспериментальными спектрами поглощения (рис. 5).

Изменение вклада слейтеровских интегралов $(F_2, G_1 \ \text{и} \ G_3)$ свидетельствует о повышении ковалентности связи между титаном и халькогеном. На это также указывает понижение степени ионности химической связи Ті-Х при переходе от серы к теллуру (для ${\rm TiS}_2$ она равна 0.22, для ${\rm TiSe}_2$ — 0.18, для TiTe₂ — 0.09), которая была рассчитана в работе [11]. Уменьшение параметра расщепления в кристаллическом поле 10Dq при переходе от серы к теллуру говорит об ослаблении взаимодействия титана с атомом лиганда, формирующим кристаллическое поле, т.е. с халькогеном. Такое поведение можно связать с увеличением параметра, характеризующего отклонение халькогенного октаэдра от идеального (табл. 1). Уменьшение гибридизации t_{2q}-орбиталей понижает соответствующий параметр T_{2g} в расчетах. Это вызвано увеличением отклонения халькогенного октаэдра от идеального при переходе S→Se→Te. Увеличение параметра решетки с не приводит к изменению гибридизации *е*_{*a*}-орбиталей.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основную информацию о формировании химической связи в дихалькогенидах титана предоставляют рентгеновские спектры поглощения $L_{2,3}$ титана и рентгеновские фотоэлектронные спектры внутренних уровней. Экспериментально по рентгеновским фотоэлектронным спектрам установлено, что в ряду ${\rm TiS}_2$, ${\rm TiSe}_2$, ${\rm TiTe}_2$ ионность химической связи уменьшается, а анализ спектров поглощения показывает, что вклад ковалентной связи увеличивается.

Согласно расчетам плотности состояний вклад $3d_{xu,x^2-u^2}$ -состояний титана в занятой части валентной полосы преобладает по сравнению с 3*d*-электронами титана другой орбитальной симметрии, р-состояния халькогена имеют почти одинаковое энергетическое распределение в направлениях x, y, zкристалла. Анализ экспериментальных спектров поглощения титана и результаты мультиплетных расчетов показывают, что в этих спектрах незаполненные t_{2g} - и e_g -орбитали титана хорошо разрешены по энергии. Величина их энергетического расщепления зависит от соотношения ионной и ковалентной составляющих в химической связи. Поэтому рентгеновские L_{2.3}-спектры поглощения титана в соединениях TiX₂ можно использовать в качестве надежного детектора для измерений ионного и ковалентного вкладов в химическую связь.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 09-08-00073-а, 10-03-96047-р_урал_а) и Уральского отделения РАН (грант № 09-м-23-2003). Работа на синхротроне ELETTRA финансировалась международным центром теоретической физики (ICTP) (проект № 20100397).

ЛИТЕРАТУРА

1. J. A. Wilson and A. Yoffe, Adv. Phys. 18, 193 (1969).

- 2. Intercalation in Layered Materials, Vol. 148 of NATO ASI Series, Series B: Physics, ed. by M. S. Dresselhaus, Plenum Press, NY and London (1986).
- 3. R. H. Friend and A. D. Yoffe, Adv. Phys. 36, 1 (1987).
- 4. R. Claessen et al., Phys. Rev. B 54, 2453 (1996).
- O. Anderson, R. Manzke, and M. Skibowski, Phys. Rev. Lett. 55, 2188 (1985).
- A. Zunger and A. J. Freeman, Phys. Rev. B 17, 1839 (1978).
- N. G. Storel, S. D. Kevan, and N. V. Smith, Phys. Rev. B 31, 8049 (1985).
- M. S. Whittingham, Belgian Patent No. 819, 672 (1973); M. S. Whittingham, US Patent No. 4009052 (1976).
- M. Zangrando, M. Finazzi, G. Paolucci et al., Rev. Sci. Instr. 72(2), 1313 (2001).
- 10. P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, and J. Luitz, WIEN2k, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal

Properties — Karlheinz Schwarz, Techn. Universitat Wien, Austria (2001).

- T. Hibma, in: Intercalation Chemistry, ed. by M. S. Wittingham and A. J. Jacobsen, Acad. Press, London (1982), p. 285.
- J. J. Yeh and I. Lindau, Atomic Data and Nuclear Data Tables, 32 (1985), p. 1.
- 13. E. Stavitski and F. D. Groot, Micron 41, 687 (2010).
- C. J. Ballhausen, Introduction to Ligand Field Theory, McGraw-Hill, New York (1962).
- 15. F. M. F. De Groot, J. C. Fuggle, B. T. Tole, and G. A. Savatzky, Phys. Rev. B 41, 12582 (1990).
- C.-O. Almbladh and L. Hedin, Handbook on Synchrotron Radiation, ed. by E. E. Koch, North-Holland, Amsterdam (1983).
- 17. B. T. Thole, G. Van der Laan, J. C. Fuggle et al., Phys. Rev. B 32, 5107 (1985).
- 18. J. Zaanen and G. A. Sawatzky, Phys. Rev. B 33, 8074 (1986).